# 双 N 沟道 MOSFET

### ELM54998WA-N

www.elm-tech.com

### ■概要

ELM54998WA-N 是 N 沟道低输入电容、低工作电压、低导通电阻的大电流 MOSFET,内藏有两个 MOSFET。

## ■特点

- Vds=100V
- Id=5.4A
- Rds(on) =  $120 \text{m} \Omega$  (Vgs=10 V)
- Rds(on) = 130m $\Omega$  (Vgs=4.5V)

## ■绝对最大额定值

如没有特别注明时, Ta=25℃

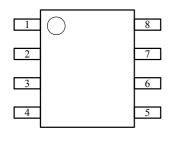
頂日		;⊐.E.	规格范围	单位	
项目		记号	<b>况价</b> 但国	-	
漏极 – 源极电压		Vds	100	$\mathbf{V}$	
栅极 – 源极电压		Vgs	± 20	V	
漏极电流 ( 定常 ) Tj=150℃	Ta=25 ℃	Id	5.4	A	
	Ta=70°C		4.2		
漏极电流(脉冲)		Idm	30	A	
容许功耗	Tc=25℃	Pd	2.8	W	
	Tc=70°C	Pa	1.8		
动作结合部温度		Tj	150	$^{\circ}\! \mathbb{C}$	
保存温度范围		Tstg	<b>−55</b> ~ 150	${}^{\circ}\!\mathrm{C}$	

## ■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位
最大结合部 – 环境热阻	Rθja		62.5	℃/W

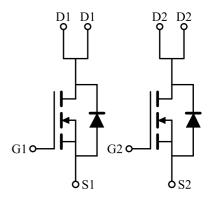
## ■引脚配置图

SOP-8(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	SOURCE1
2	GATE1
3	SOURCE2
4	GATE2
5	DRAIN2
6	DRAIN2
7	DRAIN1
8	DRAIN1

## ■电路图





# 双 N 沟道 MOSFET ELM54998WA-N

http://www.elm-tech.com

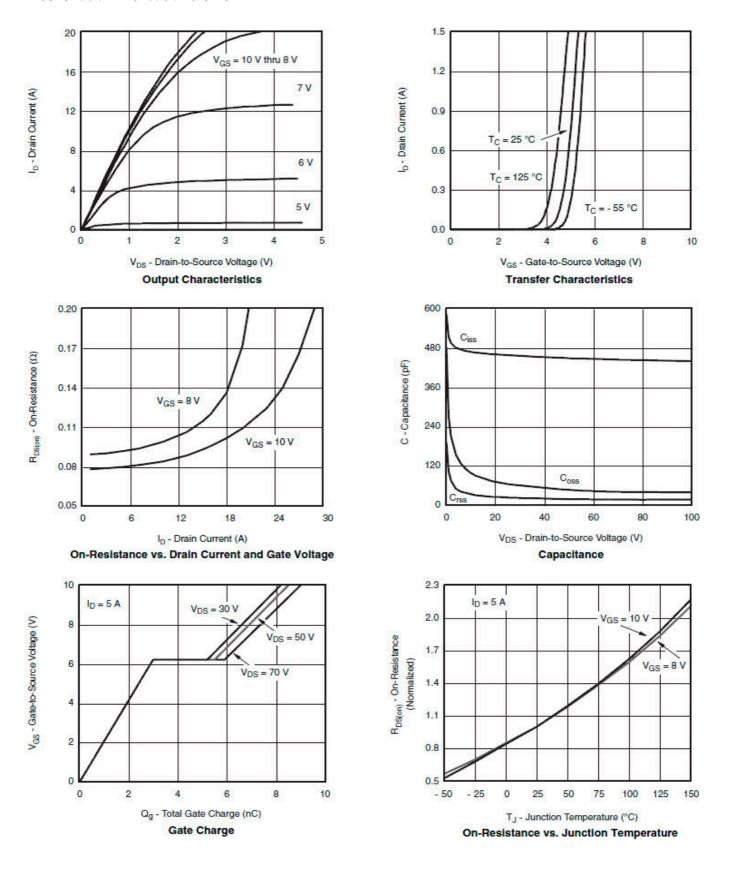
## ■电特性

如没有特别注明时, Ta=25℃

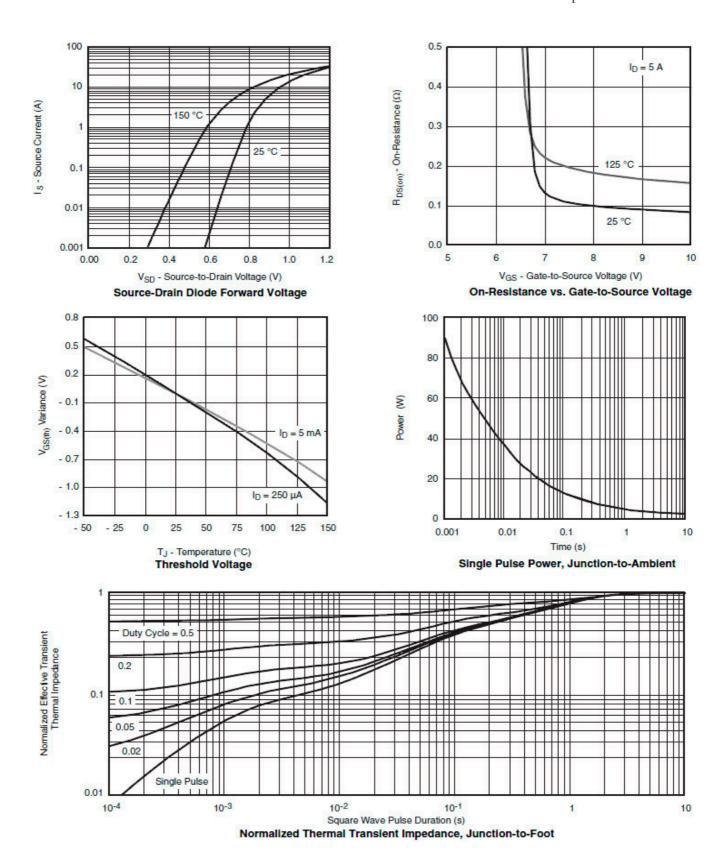
项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
静态特性							
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	Id=250 μA, Vgs=0V	100			V	
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=100V, Vgs=0V			1	μΑ	
		Vds=80V, Vgs=0V Ta=85°C			5		
栅极漏电电流	Igss	$Vds=0V, Vgs=\pm 20V$			± 100	nA	
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250 μ A	1.0		2.5	V	
导通时漏极电流	Id(on)	$Vgs=4.5V, Vds \ge 5V$	30			A	
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=10V, Id=5.6A		110	120	$$ m $\Omega$ $\perp$	
		Vgs=4.5V, Id=4.2A		114	130		
正向跨导	Gfs	Vds=15V, Id=5.3A		24		S	
二极管正向压降	Vsd	Is=2.0A, Vgs=0V		0.8	1.2	V	
寄生二极管最大连续电流	Is				1.5	A	
动态特性							
输入电容	Ciss			550		рF	
输出电容	Coss	Vgs=0V, Vds=50V, f=1MHz		80		рF	
反馈电容	Crss			50		рF	
开关特性							
总栅极电荷	Qg			10	15	пC	
栅极 – 源极电荷	Qgs	Vgs=5V, Vds=50V, Id=5.0A		4		пC	
栅极 - 漏极电荷	Qgd			5		пC	
导通延迟时间	td(on)			10	20	ns	
导通上升时间	tr	Vgs=10V, Vds=50V, Id=5.0A		10	20	ns	
关闭延迟时间	td(off)	$RL=12.5\Omega$ , Rgen= $1.0\Omega$		15	25	ns	
关闭下降时间	tf			10	25	ns	



## ■标准特性和热特性曲线



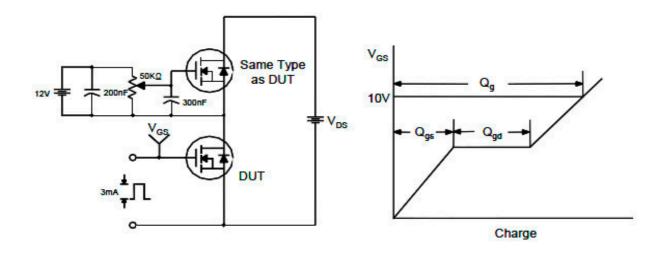




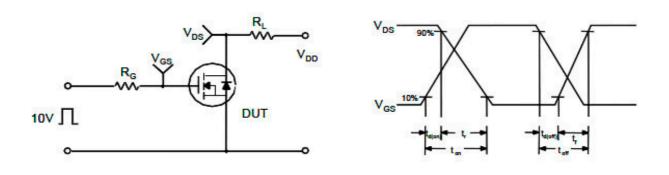


## ■测试电路和波形

#### Gate Charge Test Circuit & Waveform



#### Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



#### Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms

